

高電流容量を実現したTO-251MOSFET

48Vバッテリーのハイサイドスイッチに最適！

INJ0D10AH2



概要

INJ0D10AH2は、高許容損失パッケージにPch MOSFETを搭載し、大電流・高負荷用途に対応したMOSFETです。TO-251パッケージは、基板への挿入実装が容易で、修理・交換にも適しています。さらに、ヒートシンクや放熱板との組み合わせにより、高い放熱性と柔軟な熱設計を実現できます。

特長

- 許容損失が大きい 25W(Tc=25℃)
- 定格電流が大きい 17A (Tc=25℃)
- RDS(ON)が小さい

用途

- バッテリー(ハイサイドスイッチ)
- 産業機器、制御盤
- DCモーター制御

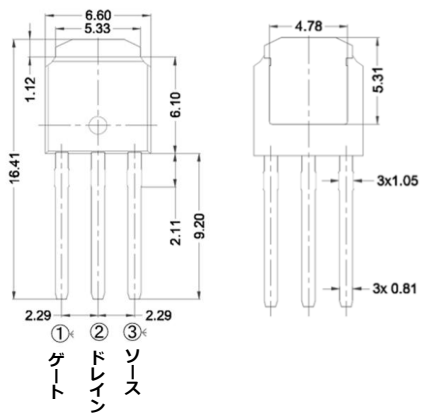
製品特性

INJ0D10AH2	最大定格(Ta=25℃)			電気的特性(Ta=25℃)			
	VDSS[V]	ID[A] Tc=25℃	PD[W] Tc=25℃	RDS(ON)[mΩ]	Ciss[pF]	tON[ns]	tOFF[ns]
	-60	-17	25	50	1900	60	150

他社情報

品種	VDSS	ID	メーカー	ステータス
2SJ598	-60	-12	RE社	EOL
H7P0601DL	-60	-20	RE社	EOL
STU10P6F6	-60	-12	ST社	EOL
NTD20P06L-1G	-60	-15.5	ON社	EOL
TSM680P06CH	-60	-14.5	TS社	ACTIVE

外形図



応用回路：

バッテリーラインのハイサイドスイッチ

